PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2004107178 A

(43) Date of publication of application: 08.04.04

(51) Int. CI

C01G 3/00 C01G 1/00 C30B 29/22 H01B 13/00

(21) Application number: 2002275559

(22) Date of filing: 20.09.02

(71) Applicant:

AISIN SEIKI CO LTD

(72), Inventor:

YOSHIKAWA MASAAKI ITO YOSHITAKA YANAGI YOSUKE MIZUTANI UICHIRO IKUTA HIROSHI

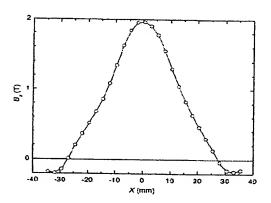
(54) OXIDE SUPERCONDUCTOR AND ITS MANUFACTURING METHOD AND HEAT TREATMENT FURNACE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an oxide superconductor having high superconductivity transition temperature by starting to grow the crystal after the oxygen concentration in a fused sample of the oxide superconductor is decreased to a specified value or lower in a fusing method of an oxide superconductor.

SOLUTION: An RE-Ba-Cu-O superconductor in a single crystal state essentially comprising metal elements of RE, Ba and Cu and having an RE $_2$ BaCuO $_5$ phase or an RE $_4$ Ba $_2$ Cu $_2$ O $_{10}$ phase of $\leq 10_{\mu}$ m average particle size finely dispersed in an REBa $_2$ Cu $_3$ O $_{7-x}$ phase shows $_{\cong}$ 94K superconductivity transition temperature in the whole superconductor. The superconductor is manufactured by sufficiently decreasing the oxygen concentration in the fused liquid in the period from the initiation of melting the source material mixture to the initiation of seeding, and then starting to grow the crystal.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-107178 (P2004-107178A)

(43) 公開日 平成16年4月8日 (2004.4.8)

(51) Int.C1. ⁷	Fi	テーマコード (参考)
CO1G 3/00	CO1G 3/00 ZAA	4G047
CO1G 1/00	CO1G 1/00 S	4GO77
C30B 29/22	C3OB 29/22 5O1B	5 G 321
HO1B 13/00	HO1B 13/00 565D	

審査請求 未請求 請求項の数 23 OL (全 22 頁)

(22) 出願日	

特願2002-275559 (P2002-275559) 平成14年9月20日 (2002.9.20) (71) 出願人 000000011

アイシン精機株式会社

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

(74) 代理人 100089082

弁理士 小林 脩

(72) 発明者 吉川 雅章

愛知県刈谷市八軒町5丁目50番地 株式

会社イムラ材料開発研究所内

(72) 発明者 伊藤 佳孝

愛知県刈谷市八軒町5丁目50番地 株式

会社イムラ材料開発研究所内

(72) 発明者 柳 陽介

愛知県刈谷市八軒町5丁目50番地 株式

会社イムラ材料開発研究所内

最終頁に続く

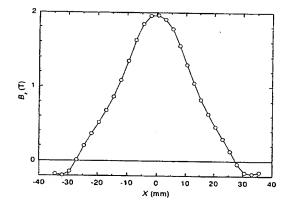
(54) 【発明の名称】酸化物超電導体、その製造方法およびその熱処理炉

(57) 【要約】

【課題】酸化物超電導体の溶融法において酸化物超電導体の試料融液中の酸素濃度が所定値以下となった後に結晶の成長を開始させることにより、超電導遷移温度の高い酸化物超電導体を作製する。

【解決手段】主な金属元素がRE、Ba、Cuからなっており、REBa₂ Cu₃ O_{7-x} 相中に、平均粒径が 10μ m以下のRE₂ BaCuO₅ 相またはRE₄ Ba₂ Cu₂ O₁₀ 相が微細に分散した単結晶状のRE-Ba-Cu-O系超電導体は超電導体全体にわたって超電導遷移温度が94 K以上である。この超電導体は、原料混合体の溶融開始からシーディング開始までの間に融液中の酸素濃度を十分低下させ、その後結晶の成長を開始させることにより作製する。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

主な金属元素がRE(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)、Ba、Cuからなっており、REBa2Cu3O $_{7-x}$ 相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)中に、平均粒径が10 $_{\mu}$ m以下のRE2BaCuO $_{5}$ 相またはRE4Ba2Cu2O $_{10}$ 1 (いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)が微細に分散した実質的に単結晶状であり、かつ原子数比で全REの50%以上がNd、Sm、Eu、Gdから選ばれた1種または複数種からなるRE-Ba-Cu-O系超電導体であって、

溶融法による製造工程において融液中の酸素濃度を制御して作製されてなることを特徴とする酸化物超電導体。

【請求項2】

RE-Ba-Cu-O(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)系超電導体の原料混合体を該超電導体の超電導相の分解温度より高い温度で加熱溶融した後に、徐冷して結晶を成長させることにより作製する酸化物超電導体の製造方法において、

結晶成長開始時における前記原料混合体の融液中に存在する酸素は飽和濃度以下であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項3】

請求項 2 において、前記原料混合体は、主としてREBa $_2$ Cu $_3$ O $_7$ - $_x$ 相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)と、RE $_2$ Ba Cu O $_5$ 相または/およびRE $_4$ Ba $_2$ Cu $_2$ O $_1$ $_0$ 相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)とからなることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項4】

RE-Ba-Cu-O(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)系超電導体の原料混合体を該超電導体の超電導相の分解温度より高い温度で加熱溶融した後に、徐冷して結晶を成長させることにより作製する酸化物超電導体の製造方法において、

前記原料混合体は、所定の配合比率のREBa2Cu3O7- $_{x}$ 相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)と、RE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2O10相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)とからなり、かつ、溶融開始から結晶成長開始での間に前記原料混合体から放出された酸素量が、前記配合比率と該配合比率における、目的とする超電導臨界温度を得るための最適な放出酸素量との相関関係を示すマップまたは曲線に基づいて導出された最適な放出酸素量以上であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項5】

請求項 4 において、前記原料混合体に含まれる R E B a $_2$ C u $_3$ O $_7$ $_ _x$ 相と、 R E $_2$ B a C u O $_5$ 相または/および R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ 相との配合比率が、モル比で、 R E B a $_2$ C u $_3$ O $_7$ $_ _x$: (R E $_2$ B a C u O $_5$ と 1 / 2 R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ の合計) = 1 : 0 . 1 ~ 1 : 1 であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項6】

請求項2~5のいずれか一項において、結晶成長開始から結晶成長終了までの雰囲気の酸素濃度が0.01%~5%であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項7】

請求項 2 ~ 6 のいずれか一項において、前記溶融および結晶成長の工程は、酸素濃度を調整した不活性ガスと酸素ガスの混合ガスの気流中で行うことを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項8】

50

40

請求項2~6のいずれか一項において、前記溶融および結晶成長の工程は、不活性ガスの気流中で行うことを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項9】

請求項2~8のいずれか一項において、前記製造方法の工程における酸素濃度の変化を計測し、それを積分することにより前記原料混合体から放出される酸素量を求めることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項10】

請求項9において、分解時の酸素放出量が既知である物質の酸素放出量を計測することによって、前記原料混合体から放出される酸素量を補正して求めることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項11】

請求項 $3\sim1$ 0 のいずれか一項において、前記RE $_2$ B a C u O $_5$ 相または前記RE $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ 相は平均粒径 1 μ m以下の粉末であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項12】

請求項2~11のいずれか一項において、前記原料混合体はAg、Pt、Rhのうち1種または複数種を単体または/および化合物の形で含有することを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項13】

請求項12において、前記Ag化合物がAg20であり、その配合比率が他の原料に対して1~30wt%の添加であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項14】

請求項2~13のいずれか一項において、前記原料混合体の溶融時の体積が10cm³以上であることを特徴とする酸化物超電導体の製造方法。

【請求項15】

加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部に所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスを導入するガス導入管と内部の気体を導出するガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、

前記耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は前記耐熱容器内の酸素濃度を前記雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されていることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項16】

加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が複数載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部に所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスを導入するガス導入管と内部の気体を導出する複数のガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、

前記耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は前記耐熱容器内の酸素濃度を前記雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されていることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項17】

請求項15において、前記耐熱容器内部の酸素濃度を測定する酸素濃度検出機構が前記ガス導出管に直列または分岐して接続されていることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項18】

請求項16において、前記耐熱容器内部の酸素濃度を測定する酸素濃度検出機構が一つにまとめられた前記複数のガス導出管に直列または分岐して接続されていることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項19】

請求項15~18のいずれか一項において、前記ガス導入管とガス導出管は前記原料混合

10

30

20

体を挟んで配置され、該ガス導入管からガス導出管に向かう気流中に前記原料混合体が載置されたことを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項20】

請求項19において、前記ガス導出管が複数である場合には同ガス導出管は前記耐熱容器の周縁部に配置され前記ガス導入管は前記耐熱容器の中央部に配置されたことを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項21】

請求項 $15\sim20$ のいずれか一項において、前記耐熱容器の容積をV [cm^3]、前記ガス導入管より導入する雰囲気ガスの流量をs [cm^3 /min]、前記原料混合体の体積(原料混合体が複数の場合には全原料混合体の体積の合計)をv [cm^3] としたとき、 $3v\leq V\leq 5s$ であることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項22】

加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部の気体を導出するガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、

前記耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は所定値以下に設定され、前記加熱炉と耐熱容器の間には所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスが充填され、前記ガス導出管には前記耐熱容器内部の酸素濃度を測定する吸引式の酸素濃度検出機構が直列に接続され、該酸素濃度検出機構により前記耐熱容器内の気体が吸引されると前記嵌合部の隙間から前記雰囲気ガスが流入されることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【請求項23】

請求項15~22のいずれか一項において、炉の温度制御用熱電対が耐熱容器内にあることを特徴とする酸化物超電導体の熱処理炉。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、溶融法で作製されたバルク状の希土類系酸化物超伝導体、その製造方法、およびそれを製造する熱処理炉に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来から、溶融法で作製されたNd、Sm系のRE-Ba-Cu-O系超電導体は知られている。この超電導体の超電導遷移温度は90K超である(例えば、特許文献 1 参照)。

[0003]

上述した溶融法ではRE、Ba、Cuの酸化物などからなる原料粉の成形体を超電導相であるREBa₂Cu₃〇ϛ(RE123)相の分解溶融温度以上に加熱し、RE₂BaLロOҕ(RE211)相またはRE₄Ba₂Cu₂〇10(RE422)相の固相とこのBa、Cu、Oからなる液相に分解し、これをゆっくりと冷却することによりRE123相の粗大な結晶を使用して、成ように作製した超電ができる。このように作製した超電が少などに指晶を使用した。このように作製することができる。このように指晶を使用は、まれにはRE211相またはRE422相の微細な粒子が分散し、砂束のピンとは結晶中にはRE211相またはRE422相の微細な粒子が分散し、としてオン半のでは、REので高いは、REのBaへの置換をでといいの高い材料を得ることができる。また溶融法において、REのBaへの置換をで作り、日の日のでは、特許では、日の日ののののでは、特許では、日の日のでは、特許では、日の日のは、特許では、日の日のは、特許では、日の日のには、特許では、日の日のでは、特許では、日の日のには、特許で作製するにしている(例えば、特許文献1参照)。

[0004]

上述したような低酸素分圧の雰囲気下で熱処理をおこなう場合、一般には密閉式のガス置換炉が用いられる。そのような炉はおおむね高価で大掛かりな装置となる。さらに本件の

10

20

30

40

10

20

[0005]

【特許文献1】

特許第2828396号公報 (第4、5ページ)

[0006]

【特許文献2】

特開平9-87093号公報(第5、6ページ、図1)

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

また、上述した熱処理炉においては、略中空箱型の部材である耐熱容器の下端部は、床部材の内周壁板および外周壁板の間に形成されている溝に緩く嵌合して保持されている。この溝と耐熱容器の下端部との間の隙間には、シール材としてのアルミナ粉末が充填されている。かかる熱処理炉はシール材を使用すると取り扱いが面倒になり、使用しなければ雰囲気の制御を確実におこなうことはできないという問題がある。また、この熱処理炉には酸素濃度を検出する手段がなく、雰囲気の制御を正確におこなうことができないという問題がある。

40

30

[0009]

本発明の目的は、酸化物超電導体の溶融法において酸化物超電導体の試料融液中の酸素濃度が所定値以下となった後に結晶の成長を開始させることにより、超電導遷移温度の高い酸化物超電導体を作製することにあり、また、シール材を設けることなく雰囲気の制御を確実におこない、かつ雰囲気中の酸素濃度を検出することにより結晶成長の制御を正確におこなうことができる熱処理炉を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するため、請求項1に係る発明の構成上の特徴は、主な金属元素がRE(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)、Ba、C

u からなっており、 R E B a $_2$ C u $_3$ O $_7$ $_ _x$ 相(結晶構造が同じで、部分的または全体に R E と B a の置換がある場合も含む)中に、平均粒径が $_1$ O $_\mu$ m 以下の R E $_2$ B a C u O $_5$ 相または/および R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ 相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体に R E と B a の置換がある場合も含む)が微細に分散した実質的に単結晶状であり、かつ原子数比で全 R E の $_5$ O %以上が N d、 S m、 E u、 G d から選ばれた $_1$ 種または複数種からなる R E $_7$ B a $_7$ C u $_7$ O $_8$ 超電導体であって、溶融法による製造工程において融液中の酸素濃度を制御して作製されてなることである。

[0011]

請求項2に係る発明の構成上の特徴は、RE-Ba-Cu-O(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)系超電導体の原料混合体を該超電導体の超電導相の分解温度より高い温度で加熱溶融した後に、徐冷して結晶を成長させることにより作製する酸化物超電導体の製造方法において、結晶成長開始時における原料混合体の融液中に存在する酸素は飽和濃度以下であることである。

[0012]

[0013]

請求項4に係る発明の構成上の特徴は、RE-Ba-Cu-O(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)系超電導体の原料混合体を該超電るのの超電導相の分解温度より高い温度で加熱溶融した後に、除足とBaの配合比率をととり作製する酸化物超電導体の製造方法において、原料混合体は、所足とBaの置点がある場合も含む)と、RE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2の10がある場合も含む)と、RE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2の10がある場合も含む)と、RE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2の10世別がある場合と、アロリンのは、からなり、アロリンのは、おける、自的とする超電導臨界温度下でを得るため、とからなり、からは一般における、目的とする超電導臨界温度下でを得るため、となり、配合比率とおける、目的とする超電導臨界温度下でを得るなめ出酸素量との相関関係を示すマップまたは曲線に基づいて導出された最適な放出酸素量との相関関係を示すマップまたは曲線に基づいて導出された最適な放出酸素量とである。

[0014]

[0015]

請求項6に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~5のいずれか一項において、結晶成長開始から結晶成長終了までの雰囲気の酸素濃度が0.01%~5%であることである。

[0016]

請求項7に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~6のいずれか一項において、溶融および結晶成長の工程は、酸素濃度を調整した不活性ガスと酸素ガスの混合ガスの気流中で行うことである。

 $[0\ 0\ 1\ 7\]$

請求項8に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~6のいずれか一項において、溶融および結晶成長の工程は、不活性ガスの気流中で行うことである。

[0018]

請求項9に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~8のいずれか一項において、製造方法の工程における酸素濃度の変化を計測し、それを積分することにより原料混合体から放出される酸素量を求めることである。

20

10

30

[0019]

請求項10に係る発明の構成上の特徴は、請求項9において、分解時の酸素放出量が既知である物質の酸素放出量を計測することによって、原料混合体から放出される酸素量を補正して求めることである。

[0020]

請求項11に係る発明の構成上の特徴は、請求項3~10のいずれか一項において、 R E $_2$ B a C u O $_5$ 相または/および R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ 相は平均粒径 1 μ m以下の粉末であることである。

 $[0 \ 0 \ 2 \ 1]$

請求項12に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~11のいずれか一項において、原料混合体はAg、Pt、Rhのうち1種または複数種を単体または/および化合物の形で含有することである。

[0022]

請求項13に係る発明の構成上の特徴は、請求項12において、Ag化合物がAg₂〇であり、その配合比率が他の原料に対して1~30wt%の添加であることである。

[0023]

請求項14に係る発明の構成上の特徴は、請求項2~13のいずれか一項において、原料 混合体の溶融時の体積が10cm³以上であることである。

[0024]

請求項15に係る発明の構成上の特徴は、加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部に所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスを導入するガス導入管と内部の気体を導出するガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は耐熱容器内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されていることである。

[0025]

請求項16に係る発明の構成上の特徴は、加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が複数載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部に所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスを導入するガス導入管と内部の気体を導出する複数のガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は耐熱容器内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されていることである

[0026]

請求項17に係る発明の構成上の特徴は、請求項15において、耐熱容器内部の酸素濃度 を測定する酸素濃度検出機構がガス導出管に直列または分岐して接続されていることである。

[0027]

請求項18に係る発明の構成上の特徴は、請求項16において、耐熱容器内部の酸素濃度 を測定する酸素濃度検出機構が一つにまとめられた複数のガス導出管に直列または分岐し て接続されていることである。

[0028]

請求項19に係る発明の構成上の特徴は、請求項15~18のいずれか一項において、ガス導入管とガス導出管は原料混合体を挟んで配置され、該ガス導入管からガス導出管に向かう気流中に原料混合体が載置されたことである。

[0029]

請求項20に係る発明の構成上の特徴は、請求項19において、ガス導出管が複数である場合には同ガス導出管は耐熱容器の周縁部に配置されガス導入管は耐熱容器の中央部に配置されたことである。

[0030]

20

30

20

30

40

50

請求項21に係る発明の構成上の特徴は、請求項15~20のいずれか一項において、耐熱容器の容積を $V[cm^3]$ 、ガス導入管より導入する雰囲気ガスの流量を $s[cm^3/min]$ 、原料混合体の体積(原料混合体が複数の場合には全原料混合体の体積の合計)を $v[cm^3]$ としたとき、 $3v \leq V \leq 5s$ であることである。

[0031]

請求項22に係る発明の構成上の特徴は、加熱炉と該加熱炉内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体が載置される耐熱容器を備え、該耐熱容器には内部の気体を導出するガス導出管を設けてなり、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉であって、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は所定値以下に設定され、加熱炉と耐熱容器の間には所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスが充填され、ガス導出管には耐熱容器内部の酸素濃度を測定する吸引式の酸素濃度検出機構が直列に接続され、該酸素濃度検出機構により耐熱容器内の気体が吸引されると嵌合部の隙間から雰囲気ガスが流入されることである。

[0032]

請求項23に係る発明の構成上の特徴は、請求項15~22のいずれか一項において、炉の温度制御用熱電対が耐熱容器内にあることである。

[0033]

【発明の作用・効果】

上記のように構成した請求項1に係る発明においては、超電導体全体にわたって超電導遷移温度が高い(例えば94K以上)RE-Ba-Cu-O系超電導体を得ることができる

[0034]

上記のように構成した請求項2に係る発明においては、酸化物超電導体を製造する溶融法にて結晶成長開始時における原料混合体の融液中に溶存する酸素は飽和濃度以下となっているので、結晶が成長する融液中では実質的に酸素濃度が十分に低くなっており超電導遷移温度が高い(例えば94K以上)RE-Ba-Cu-O系超電導体を得ることができる。また、融液と雰囲気の酸素濃度が平衡になるには、ある程度の時間を要するので、雰囲気の酸素分圧が例えば大気程度に高くても比較的高い超電導遷移温度のRE-Ba-Cu-O系超電導体を得ることができる。

[0035]

上記のように構成した請求項 3 に係る発明においては、原料混合体は、主としてREBa₂ С u_3 О $_7$ $_ _x$ 相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)と、RE $_2$ BaC u О $_5$ 相または/およびRE $_4$ Ba₂ С u_2 О $_1$ $_0$ 相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)とから構成されているので、RE123超電導相の中に常電導相であるRE211相が適当に分散した組織を簡単に形成することができる。

[0036]

[0037]

[0038]

上記のように構成した請求項6に係る発明においては、結晶成長開始から結晶成長終了までの雰囲気の酸素濃度が0.01%~5%であることが好ましい。この場合、十分低くなった融液中の酸素濃度をほぼ維持したまま結晶成長が起こるので、この工程中にてREがBaに置換するのを防止することができる。

[0039]

上記のように構成した請求項7に係る発明においては、溶融および結晶成長の工程は、酸素濃度を調整した不活性ガスと酸素ガスの混合ガスの気流中で行うので、制御性よくこの工程中にてREがBaに置換するのを防止することができる。

[0040]

上記のように構成した請求項8に係る発明においては、溶融および結晶成長の工程は、不活性ガスの気流中で行うので、この工程中にてREがBaに置換するのを防止することができる。

[0041]

上記のように構成した請求項9に係る発明においては、製造方法の工程における酸素濃度の変化を計測し、それを積分することにより原料混合体から放出される酸素量を求めるので、確実かつ正確に放出酸素量を算出することができる。

[0042]

上記のように構成した請求項10に係る発明においては、分解時の酸素放出量が既知である物質の酸素放出量を計測することによって、原料混合体から放出される酸素量を補正して求めるので、より正確な放出酸素量を算出することができる。

[0043]

上記のように構成した請求項11に係る発明においては、RE $_2$ BaCuO $_5$ 相または/およびRE $_4$ Ba $_2$ Cu $_2$ O $_1$ $_0$ 相は平均粒径1 $_\mu$ m以下の粉末であるので、合成された超電導体においてより高いピン止め作用を発揮することができる。

[0044]

上記のように構成した請求項12に係る発明においては、原料混合体はAg、Pt、Rhのうち1種または複数種を単体または/および化合物の形で含有するので、作製された酸化物超電導体の強度を向上させ、また211相の粗大化を防止することができる。

[0045]

上記のように構成した請求項13に係る発明においては、Ag化合物がAg2Oであるので、Agをより均一かつ微細に分散することができる。また、その配合比率が他の原料に対して1~30wt%の添加であるので、臨界電流密度などの超電導特性を損なうことなく超電導体の強度を向上することができる。

[0046]

上記のように構成した請求項14に係る発明においては、原料混合体の溶融時の体積が1 0cm³以上であるので、比較的大型な酸化物超電導体を作製することができる。

[0047]

上記のように構成した請求項15に係る発明において、溶融法により酸化物超電導体を製

10

20

30

20

30

40

50

造する熱処理炉は加熱炉内に耐熱容器が配置されてなり、耐熱容器には内部に所定濃度の酸素がスを含む雰囲気がスを導入するガス導入管と内部の気体を導出するガス導出管が設けられ、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は耐熱容器内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されている。これによれば、酸化物超電導体を製造する工程において耐熱容器内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を製造するのに最適な雰囲気を提供することができる。

[0048]

上記のように構成した請求項16に係る発明においては、溶融法により酸化物超電導体を複数製造する熱処理炉は加熱炉内に耐熱容器が配置されてなり、耐熱容器には内部に所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスを導入するガス導入管と内部の気体を導出する複数のガス導出管が設けられ、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は耐熱容器内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されている。これによれば、複数の酸化物超電導体を同時に製造する工程において耐熱容器内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を複数製造するのに最適な雰囲気を提供することができる

[0049]

上記のように構成した請求項17に係る発明においては、耐熱容器内部の酸素濃度を測定する酸素濃度検出機構がガス導出管に直列または分岐して接続されているので、耐熱容器から導出される気体の酸素濃度の時間的変化を測定することにより簡単に原料混合体からの酸素放出量を検出することができる。

[0050]

上記のように構成した請求項18に係る発明においては、耐熱容器内部の酸素濃度を測定する酸素濃度検出機構が複数のガス導出管を一つにまとめてこれに直列または分岐して接続されているので、耐熱容器から導出される気体の酸素濃度の時間的変化を測定することにより簡単に原料混合体からの酸素放出量を検出することができる。

[0051]

上記のように構成した請求項19に係る発明においては、ガス導入管とガス導出管は原料混合体を挟んで配置され、該ガス導入管からガス導出管に向かう気流中に原料混合体が載置されているので、原料混合体は常に新しい雰囲気ガスに曝されている。これにより原料混合体の周囲は常にほぼ一定の酸素濃度とすることができる。

[0052]

上記のように構成した請求項20に係る発明においては、ガス導出管が複数である場合には同ガス導出管は耐熱容器の周縁部に配置されガス導入管は耐熱容器の中央部に配置されるので、耐熱容器の中央部から導入された雰囲気ガスは周縁部に向かって流れてガス導出管を通って導出される。したがって、耐熱容器内に所定の酸素濃度の雰囲気ガスを均一に供給することができる。

[0053]

上記のように構成した請求項 2 1 に係る発明においては、耐熱容器の容積を V $[cm^3]$ 、ガス導入管より導入する雰囲気ガスの流量を s $[cm^3/min]$ 、原料混合体の体積(原料混合体が複数の場合には全原料混合体の体積の合計)を v $[cm^3]$ としたとき、 3 v \leq V \leq 5 s の関係を満たしている。これにより、原料混合体は耐熱容器内に適当な空間をおいて載置されるので、温度分布の乱れによる影響を抑えることができる。また、耐熱容器の容積に対して適当な雰囲気ガスの流量が設定されるので、耐熱容器内の酸素濃度が短時間で平衡に達することができる。

[0054]

上記のように構成した請求項22に係る発明においては、溶融法により酸化物超電導体を製造する熱処理炉は加熱炉内に耐熱容器が配置されてなり、加熱炉と耐熱容器の間には所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスが充填され、耐熱容器には内部の気体を導出するガス

20

30

40

50

導出管が設けられ、耐熱容器は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され該容器部材の嵌合部の隙間は所定値以下に設定され、ガス導出管には耐熱容器内部の酸素濃度を測定する吸引式の酸素濃度検出機構が直列に接続され、該酸素濃度検出機構により耐熱容器内の気体が吸引されると嵌合部の隙間から加熱炉内の雰囲気ガスが流入される。これによれば、酸化物超電導体を製造する工程において耐熱容器内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を製造するのに最適な雰囲気を提供することができる。

[0055]

上記のように構成した請求項23に係る発明においては、炉の温度制御用熱電対が耐熱容器内にあるので、耐熱容器内の温度を正確かつ確実に測定することができる。

[0056]

【発明の実施の形態】

本発明による酸化物超電導体は、主な金属元素がRE(REはYを含む希土類元素のうちの1種類または2種類以上の組み合わせ)、Ba、Cuからなっており、REBa2CuO3O7-x相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む。以下RE123相という。)中に、平均粒径が10 μ m以下のRE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2O10相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む。以下RE211相という。)が微細に分散は全体にREとBaの置換がある場合も含む。以下RE211相という。)が微細に分散した単結晶状のRE-Ba-Cu-O系超電導体であって、原子数比で全REの50%以上がNd、Sm、Eu、Gdから選ばれた1種または複数種からなっており、溶融法による製造工程において融液中の酸素濃度を制御して作製されてなるものである。なお、REがLa、Ndである場合にRE4Ba2Cu2O10相となり、Sm、Eu、Gdである場合にRE4Ba2Cu2O10相となり、Sm、Eu、Gdである場合にRE2BaCuO5

[0057]

本発明の酸化物超電導体の実施例1~3について以下に説明する。

a) 実施例 1

まず実施例1について説明するが、この実施例1にて使用する熱処理炉について図1を参照して説明する。この熱処理炉は、加熱炉11とこの加熱炉11内に配置されて内部に酸化物超電導体の原料混合体12(後述する)が載置される耐熱容器13を備えている。加熱炉11は内部に耐熱容器13を収容する箱状の加熱炉本体11aと、この本体11aを覆蓋する蓋11bから構成されている。加熱炉本体11aの底には加熱手段11c(ヒータ)が載置されこの上に耐熱容器13が支持され、加熱手段11cにより耐熱容器13が加熱されている。

[0058]

耐熱容器13は内部に原料混合体12を収容する箱状の容器本体13aとこの本体13aをほぼ気密に覆蓋する蓋13bから構成されている。蓋13bの周縁部には凹部13cが形成されておりこの凹部13cと容器本体13aの上端が嵌合している。この嵌合部13dの隙間は耐熱容器13内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度(例えば、0.1mm以下)に設定されている。これにより、耐熱容器13内は嵌合部13dの隙間を通して加熱炉11内に連通している。これによれば、酸化物超電導体を製造する工程において耐熱容器13内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を製造するのに最適な雰囲気を提供することができる。なお、耐熱容器13の容積は約950cm³である。

[0059]

耐熱容器 1 3 の蓋 1 3 bには、ガス導入管 1 4、ガス導出管 1 5、種結晶導入管 1 6、熱電対挿入管 1 7の4本のセラミックス製のパイプが蓋 1 3 bを貫通して気密に取り付けられている。これらパイプ 1 4~1 7 は加熱炉 1 1 の蓋 1 1 bも貫通して気密に固定されており、加熱炉 1 1 外部に突出している。ガス導入管 1 4 の上端は酸素ガス供給源 1 4 a およびアルゴンガス供給源 1 4 b に接続されており、耐熱容器 1 3 内には所定濃度の酸素ガスを含む酸素ガスとアルゴンガスからなる雰囲気ガスが導入されている。(酸素ガス供給

20

30

40

50

源14aから供給される毎分10cm³の酸素ガスとアルゴンガス供給源14bから供給される毎分990cm³のアルゴンガスとが混合されて酸素濃度1%の混合ガス(雰囲気ガス)が毎分1000cm³にて供給されている。)

[0060]

ガス導出管 1 5 の上端は排気管 1 5 a に接続されており、耐熱容器 1 3 内の気体が外部に導出され、またガス導出管 1 5 の上端は分岐されて酸素濃度計 1 8 に接続されており、耐熱容器 1 3 内の気体が酸素濃度計 1 8 を通って外部に導出されている。導出ガスのうち毎分 2 0 0 c m 3 を酸素濃度計 1 8 でサンプリングし、残りを排気管 1 5 a から放出するようになっている。酸素濃度計 1 8 が耐熱容器 1 3 内の酸素濃度を検出する。

$[0\ 0\ 6\ 1\]$

また、ガス導入管14およびガス導出管15の各下端は、図1(b)に示すように、耐熱容器13の蓋13bの互いに対向する角部に取り付けられており、耐熱容器13の底中央部に載置された原料混合体12を挟んで配置される。これにより、ガス導入管14からガス導出管15に向かう気流(図1(b)における破線矢印にて示す)中に原料混合体12が載置されるので、原料混合体12は常に新しい雰囲気ガスに曝されている。したがって、原料混合体12で酸素の吸放出が起きた場合にも原料混合体12の周囲は常にほぼ一定の酸素濃度とすることができる。

[0062]

種結晶導入管16は耐熱容器13内に種結晶19を導入するものであり、種結晶導入管16の上端には着脱自在なキャップ16aが気密に取り付けられ、種結晶導入管16の下端は耐熱容器13の底中央部に載置された原料混合体12の中心部の直上に臨んでいる。支持棒16bの先端に固定された種結晶19が種結晶導入管16の上端から挿入され、原料混合体12の上面中心部に載置される。熱電対挿入管17は耐熱容器13内の温度を検出する熱電対17aを耐熱容器12の底まで挿入するものであり、熱電対挿入管17の下端はには伸縮可能なキャップ(図示省略)が気密に取り付けられ、熱電対挿入管17の下端は耐熱容器13の蓋13bの角部に取り付けられている。熱処理炉の温度制御用熱電対17aが耐熱容器13内にあるので、耐熱容器13内の温度を正確かつ確実に測定することができる。

[0063]

次に上述した熱処理炉による酸化物超電導体の製造方法について説明する。原料粉は S m $1\ 2\ 3$ 、 S m $2\ 1\ 1$ 、 A g $_2$ O 、 P t の各粉末を混合したものであり、 S m $1\ 2\ 3$ と S m $2\ 1\ 1$ の混合比が $3\ :\ 1$ となるように、すなわち S m 、 B a 、 C u のモル比が $5\ :\ 7\ :\ 1$ 0 となるように設定されている。 さらに S m $1\ 2\ 3$ と S m $2\ 1\ 1$ の合計に対し A g $_2$ O が 重量で $2\ 0$ %、 P t は同じく 0 . $5\ %$ 添加されている。この原料粉を直径 $7\ 6$ m m 、 厚 み $3\ 0$ m m の 円 盤状に 一軸 圧粉 成型 した 原料混合体 $1\ 2$ を 図 1 に示すように 耐熱 容器 $1\ 3$ の 底中央に 載置 し、この 耐熱 容器 $1\ 3$ を 加熱 炉 $1\ 1$ 内に 設置 して 各蓋 $1\ 3$ a 、 $1\ 1$ a を 取 り 付ける。

[0064]

さらに耐熱容器13内には、酸素ガス供給源およびアルゴンガス供給源からガス導入管14を介して酸素濃度を1%に調整した酸素とアルゴンの混合ガス(雰囲気ガス)が毎分1000cm³にて供給されている。一方耐熱容器13内の気体はガス導出管15を介して毎分200cm³にて吸引されてその酸素濃度が計測され、残りのガスは排気管15aから排出されている。また耐熱容器13内の温度は熱電対17aにより計測されている。これら酸素濃度と炉内温度は同時に記録計によって記録されている。

[0065]

そして熱処理は図2に示す温度制御が熱電対により検出した温度に基づいておこなわれる。耐熱容器13内の酸素濃度が十分低下し安定した後(図2における区間 a)、耐熱容器13内の温度を室温から400℃まで毎分1℃で昇温し(図2における区間 b)、その温度にて4時間保持し(図2における区間 c)、その後800℃まで2時間(図2における区間 e)、1110℃まで2時間

20

40

50

で昇温し(図 2 における区間 f)、その温度にて 1 時間 3 0 分保持した(図 2 における区間 g)。その後 3 0 分で 1 0 0 7 \mathbb{C} まで降温し(図 2 における区間 h)、さらに降温しながら 1 0 0 4 \mathbb{C} において主として N d - B a - C u - O の 1 2 3 相からなる種結晶 1 9 を原料混合体 1 2 上面中央に接触させる(シーディングする)(図 2 における時点 i)。その後 1 0 0 1 \mathbb{C} から毎時 0 . 2 \mathbb{C} で 1 0 0 時間、さらに毎時 0 . 5 \mathbb{C} で 6 0 時間徐冷し種結晶 1 9 を起点として S m 1 2 3 相の結晶を包晶反応により成長させた(図 2 における区間 j 以降)。

[0066]

かかる熱処理をおこなう一方で、耐熱容器13内から導出される気体の酸素濃度が計測されており、この測定結果を図2に示す。これによれば、酸素濃度のピークは3箇所あり、左から1つめのピークはAg2〇が分解したときに発生した酸素濃度を示しており、左から3つめのピークはSm123が分解(溶融)したときに発生した酸素濃度を示している。いずれにおいても計測した酸素濃度をピークの範囲内にて積分することによりそのピークに発生した酸素量を算出することができる。したがって、確実かつ正確に放出酸素量を算出することができる。

[0067]

Sm123が分解(溶融)したときすなわち区間 $f\sim h$ を詳述する。 Sm123は1000 $\mathbb C$ を超えると、下記化1に従ってSm211と液相(主としてBaとCuの複合酸化物)に分解され原料混合体は部分溶融状態となる。このとき、原料混合体では酸素ガスが発生して放出される。

[0068]

【化1】

S m B a $_2$ C u $_3$ O $_6$ \rightarrow 1 / 2 S m $_2$ B a C u O $_5$ + 1 / 2 B a $_3$ C u $_5$ O $_x$ + y O $_2$

なお、上記化 1 において S m B a $_2$ C u $_3$ O $_6$ および S m $_2$ B a C u O $_6$ は固相であり、 D a $_3$ C u $_5$ O $_x$ は液相であり、 O $_2$ は気体である。

[0069]

このことは図2の測定結果からも明らかである。区間 f においてはSm123の溶融がさらに進み融液が増加しその分放出される酸素量は増加する。区間 g , h においては S m 1 2 3 の溶融がらなるSm123の溶融はなくなり、融液中に残存する酸素が放出されるだけなので、時間の経てば経つほど放出される酸素量は減少する。そして、測定された酸素濃度と時しくなる。するでは耐熱容器13内に供給される雰囲気ガスの酸素濃度と等しくなる。する。 p 料混合体からは酸素ガスが放出されなくなる。またこの区間 f ~h において酸素濃度の食力値から求めた溶融時の酸素放出量は2.74gであり、原料粉のSm123相1molあたりでは7.25gとなりこれは酸素原子 0.453m01(上記化1における2yの値)に相当する。また、上記化1におけるxとyの間には、x/2+2y=3.5の関係があることから融液中に存在する酸素原子モル数(x/2)はSm123相1モルあたり3.047m01と推定される。ただし、正確にはSmが少量(~数wt%)融液中に溶解するがそれを無視する。

[0070]

上述した熱処理により作製した超電導体を研削加工して直径59mm厚み11mmの円盤状試料を作成し、酸素気流中で400℃から350℃の間で500時間のアニール処理を施し、補強のため試料の周囲にエポキシ樹脂を塗布しその外にステンクのサセスのリングを性をでした。この試料について磁場を印加し、液体窒素により77Kに冷却した後、印加た結果の分布をホール素子によって測定したが場を0にした。これにより試料に捕捉された磁場の分布をホール素子によって測定したが場を0にした。これにより試料に捕捉された磁場の分布をホール素子によった。にとから高いである式料にないである試料中央部においても周縁部と同程度の比較の高い超電導臨界温度Tcは91.8Kで周縁部の超電導臨界温度Tcは91.8Kで周縁部の超電導臨界温度Tcは94.7Kであった。

[0071]

b) 実施例 2

[0072]

実施例 2 によれば、図 2 に示す区間 f ~ h において酸素濃度の積分値から求めた溶融時の酸素放出量は 2 . 8 1 g であり、原料粉の S m 1 2 3 相 1 m o 1 あたりでは 7 . 4 4 g となりこれは酸素原子モル数 2 y = 0 . 4 6 5 m o 1 に相当する。この時の融液中に存在する酸素原子モル数 x / 2 は 3 . 0 3 5 m o 1 と推定される。また、実施例 2 の熱処理により作製した超電導体に捕捉された磁場の分布をホール素子によって測定した結果、図 4 のような円錐状の磁場分布が得られた。捕捉磁場分布が円錐状になったことから、種結単ならの結晶成長開始初期である試料中央部においても周縁部と同程度の比較的高い超電導臨界温度 T c が得られていることがわかる。実際、同条件で作製した試料中央部の超電導臨界温度 T c は 9 4 . 8 K であった。

[0073]

c) 実施例3

次に実施例3について説明する。この実施例3においても実施例2にて使用したものと同様な熱処理炉を使用している。また、実施例1と同様に耐熱容器13内の酸素濃度と温度を測定してこれら測定結果に基づいて熱処理をおこなっている。この実施例3は原料粉のSm123とSm211の混合比が5:1となるように、すなわちSm、Ba、Cuのモル比が7:11:16となるように設定されている点で実施例1と異なる。また、熱処理において図2における区間fにて1070℃まで1時間で昇温した点で実施例1と異なる。なお、その後30分で1011℃まで降温し(図2における区間h)、さらに降温しながら1008℃にて種結晶19を原料混合体12上面中央にシーディングした点でも実施例1と異なる。

[0074]

実施例3によれば、図2に示す区間 f ~ h において酸素濃度の積分値から求めた溶融時の酸素放出量は2.40gであり、原料粉のSm123相1molあたりでは5.81gとなりこれは酸素原子0.363molに相当する。この時の融液中に存在する酸素原子モル数 x / 2 は3.137molと推定される。また、実施例3の熱処理により作製した超電導体に捕捉された磁場の分布をホール素子によって測定した結果、図5のような円錐状の磁場分布が得られた。捕捉磁場分布が円錐状になったことから、種結晶からの結晶は長開始初期である試料中央部においても周縁部と同程度の比較的高い超電導臨界温度Tcは94.8 K であった。

[0075]

d) 比較例

次に比較例について説明する。この比較例においては実施例1にて使用したものと同様な熱処理炉、原料粉および原料混合体12を使用している。また、実施例1と同様に耐熱容器13内の酸素濃度と温度を測定してこれら測定結果に基づいて熱処理をおこなっている。この比較例は熱処理において図2における区間fの昇温温度および区間gの保持温度が実施例1(1110℃)と比べて1070℃と低いという点で実施例1と異なる。

[0076]

比較例によれば、図2に示す区間 f ~ h において酸素濃度の積分値から求めた溶融時の酸

10

20

30

20

30

40

50

素放出量は2.54gであり、原料粉のSm123相1molあたりでは6.71gとなりこれは酸素原子0.419molに相当する。この時の融液中に存在する酸素原子モル数 x / 2 は3.0 8 1 molと推定される。また、比較例の熱処理により作製した超電導体に捕捉された磁場の分布をホール素子によって測定した結果、図6のような分布が得られた。すなわち、中央部は磁場の勾配がほとんどなく周縁部に比べて超電導臨界温度Tcは 8 3.3 Kで周縁部の超電導臨界温度Tcは 9 4.8 Kであった。

[0077]

上述した実施例1と比較例の結果から明らかなように、図2に示す区間f~hにおいて溶融時の酸素放出量は実施例1のほうが多い。これは、実施例1は区間gにおける保持温度が比較例に比べて十分高いため、融液中に残存する酸素の雰囲気中への放出速度が速くなったので、Sm123の溶融に伴って発生したほとんどの酸素が融液中から耐熱容器13の雰囲気中に放出されるためと推定される。言い換えると、原料混合体の融液中に存在する酸素が飽和濃度以下となるためである。これによりシーディング以降(図2に示す時点も設置が飽和濃度する融液中で実質的に酸素濃度が十分低下され、これによりREのBaへの置換が極力抑制されることとなり、中央部の超電導臨界温度Tcが周縁部と同等に高い超電導体が作製される。

[0078]

また上述した実施例1と比較例の結果から明らかなように、原料粉のSm123とSm211とが同じ配合比率である場合には、溶融開始までの間(図2における区間 f~h)に放出された酸素量と試料中央部の超電導降下 c との関係を精性のよい酸化物超電導体を作製することができる。例えば、Sm123:Sm211=3:1の配合比率において目的とする超電導にからまず、Sm123:Sm211=3:1の配合比率について、超電導臨界温度T c と放出電導になった結果を図7には、実施例1~3の結果に加え、超電導との関係を調べた結果を図7には、実施例1~3の結果に加え、超電導に大たをは出量が0.48mの1以ておるのデータもプロットしてある。この図7によれば、酸素放出量が0.48mの1以ておれば、試料中央部の超電導臨界温度T c が94 K 以上であるを作製することがでるを1、図7には酸素放出量に対応する酸素量(上記化1におけるを1、図7には酸素放出量に対応する酸素量(上記化1におけるを1、図7には酸素放出量に対応する酸素を1、図7には酸素が出量に対応する酸素を1、02mの1以下すなわち融液を1、図7には酸素が出量に対応するででする。これによれば、x/2が3.02mの1以下すなわち融液のまた、図7には酸素が出量に対応するででする。3:5:6.04で表される超導体を作製することができる。

[0079]

さらに実施例1と実施例3の結果から明らかなように、原料粉のSm123とSm211 とが異なる配合比率である場合には、Sm211の比率が高いものほど融液中からより多 くの酸素を放出させないと特性のよい酸化物超電導体を作製することができない。以上の ことから、原料粉のSm123とSm211との配合比率と、この配合比率における、目 的とする超電導臨界温度Tcを得るための最適な放出酸素量との間には図8に示すマップ または曲線で表される相関関係があると考えられる。そして、溶融開始から結晶成長開始 までの間に原料混合体から放出された酸素量がこのマップまたは曲線に基づいて導出され た、目的とする超電導臨界温度Tcを得るための最適な放出酸素量以上であれば、融液中 から十分な酸素が放出される。これにより結晶が成長する融液中では実質的に酸素濃度が 十分に低くすることができるので、目的とする超電導臨界温度Tc (94K)以上のRE - Ba-Cu-O系超電導体を得ることができる。また、融液中に存在する酸素量に対し ても、同様なマップまたは曲線を描くことができ、同様にして特性のよい超電導体を得る ことができる。なお、図8に示す原料粉のSm123とSm211との配合比率と、この 配合比率における、目的とする超電導臨界温度Tcを得るための最適な放出酸素量との相 関関係を示すマップまたは曲線は、各配合比率において図7を得る実験を行うことにより 求めることができる。さらにREの種類が異なる場合、このマップまたは曲線も変化する

と考えられ、それについても同様に実験によって求めることができる。

$[0 \ 0 \ 8 \ 0]$

なお、原料混合体に含まれる R E B a $_2$ C u $_3$ O $_7$ $_ _x$ 相と、 R E $_2$ B a C u O $_5$ 相または $_2$ は R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ 相との配合比率は、モル比で、 R E B a $_2$ C u $_3$ O $_7$ $_ _x$: (R E $_2$ B a C u O $_5$ と $_1$ $_2$ R E $_4$ B a $_2$ C u $_2$ O $_1$ $_0$ の合計) = $_1$: 0 . 1 $_2$ 1 : 1 であることが望ましい。これによれば、より適切な配合比率の原料混合体から R E $_2$ B a $_3$ C u $_4$ O $_4$ X 以上) R E $_3$ B a $_4$ C u $_4$ O $_4$ X 超電導体を得ることができる。

[0081]

なお本発明においては、原料混合体は、主としてREBa₂ Cu₃ O_{7-x} 相(結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)と、RE₂ BaCuO₅ 相または/およびRE₄ Ba₂ Cu₂ O₁₀ 相(いずれも結晶構造が同じで、部分的または全体にREとBaの置換がある場合も含む)とからなることが望ましい。これによりRE123超電導相の中に常電導相であるRE211相が適当に分散した組織を簡単に形成することができる。

[0082]

また本発明においては、結晶成長開始から結晶成長終了まで(図2における区間 $f \sim h$)の雰囲気の酸素濃度が $0.01\% \sim 5\%$ であることが望ましい。これによれば、この工程中にてREがBaに置換するのを極力防止することができる。

[0083]

また本発明においては、溶融および結晶成長の工程(図2における区間f以降)は、酸素 濃度を調整した不活性ガスと酸素ガスの混合ガスの気流中あるいは不活性ガスの気流中で 行うことが好ましい。これによれば、この工程中にてREがBaに置換するのを防止する ことができる。

[0084]

また本発明においては、分解時の酸素放出量が既知である物質例えばAg₂ 〇の酸素放出量を計測することによって、原料混合体から放出される酸素量を補正して求めることが好ましい。具体的には、Ag₂ 〇が溶融したときに発生する酸素量を予め測定しておき、この酸素量と、上述した熱処理中のAg₂ 〇が溶融したときに発生する酸素量と比較して、この比較結果に基づきSm123が分解(溶融)したときに発生した酸素量を補正する。これにより、より正確な放出酸素量を算出することができる。

[0085]

また本発明においては、RE2BaCuO5相または/およびRE4Ba2Cu2O10 相は平均粒径 1μ m以下の粉末であることが好ましい。これによれば合成された超電導体においてより高いピン止め作用を発揮することができる。

[0086]

また本発明においては、原料混合体はAg、Pt、Rhのうち1種または複数種を単体または/および化合物の形で含有することが好ましい。これによれば、作製された酸化物超電導体の強度を向上させ、またRE211相の粗大化を防止することができる。

[0087]

また本発明においては、Ag化合物が Ag_2 Oであり、その配合比率が他の原料に対して $1\sim30$ wt%の添加であることが好ましい。これによれば、Agをより均一かつ微細に分散することができ、また臨界電流密度などの超電導特性を損なうことなく超電導体の強度を向上することができる。

[0088]

また本発明においては、原料混合体の溶融時の体積が 1 0 c m 3 以上であることが好ましい。これによれば、比較的大型な酸化物超電導体を作製することができる。

[0089]

また、上述した各実施例に使用した熱処理炉においては、ガス導出管15を分岐して酸素 濃度計18を設けて導出される耐熱容器13内の酸素濃度を測定することにより放出酸素

20

10

30

40

量を算出するようにしていたが、図9に示すように、酸素濃度計18を削除するようにしてもよい。このとき、計測した酸素濃度に基づいて温度制御または/およびシーディングのタイミングを図るのではなく、図1に示す構成で目的とする超電導臨界温度Tcが得られる図2のようなタイミングチャートを予め決定しておき、これに基づき温度制御または/およびシーディングのタイミングを図るようにすればよい。これによれば、より安価な熱処理炉を提供することができる。なお、他の構成については同一符号を付してその説明を省略する。また、酸素ガス供給源14a、アルゴンガス供給源14b、キャップ16aおよび排気管15aは図9に示されていない。

[0090]

また、上述した各実施例に使用した熱処理炉においては、原料混合体12を1つだけ作製 したが、図10に示すように、複数個作製するようにしてもよい。さらに、種結晶19を 熱処理の途中で接触(シーディング)させるのではなく、予め原料混合体12に設置して おき、種結晶19が融けない温度で熱処理を実施してもよい。この場合、図10(b)に 示すように、耐熱容器13の底には複数の原料混合体12が縦横2列すなわち4個載置さ れ、ガス導入管14の下端はこれらの中央すなわち耐熱容器13の蓋13aの中央に取り 付けられ、複数(4本)のガス導出管15は耐熱容器13の蓋13aの各角部に取り付け られている。これにより、ガス導入管14からガス導出管15に向かう気流 (図10 (b)における破線矢印にて示す)中に各原料混合体12が載置されるので、原料混合体12 は常に新しい雰囲気ガスに曝されている。したがって、原料混合体12で酸素の吸放出が 起きた場合にも原料混合体12の周囲は常にほほ一定の酸素濃度とすることができる。ま た、ガス導出管15が複数である場合には各ガス導出管15は耐熱容器13の周縁部に配 置されガス導入管14は耐熱容器13の中央部に配置されるので、耐熱容器13の中央部 から導入された雰囲気ガスは周縁部に向かって流れてガス導出管15を通って導出される 。したがって、耐熱容器13内に所定の酸素濃度の雰囲気ガスを均一に供給することがで きる。

[0091]

なお、耐熱容器13は少なくとも2個の容器部材が嵌合するように構成され容器部材13の嵌合部13 d の隙間は耐熱容器13内の酸素濃度を雰囲気ガスの酸素濃度に維持できる程度に設定されている。また、他の構成については同一符号を付してその説明を省略する

[0092]

したがって、複数の酸化物超電導体を同時に製造する工程においても耐熱容器 1 3 内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を複数製造するのに最適な雰囲気を提供することができる。

[0093]

また、耐熱容器 1 3 内部の酸素 濃度を測定する酸素濃度計 1 8 が一つにまとめられた複数のガス導出管 1 5 に直列または分岐して接続されているので、耐熱容器 1 3 から導出される気体の酸素濃度の時間変化を測定することにより簡単に原料混合体からの酸素放出量を検出することができる。

[0094]

また本発明による熱処理炉においては、耐熱容器13の容積をV[cm³]、ガス導入管14より導入する雰囲気ガスの流量をs[cm³/min]、原料混合体12の体積(原料混合体12が複数の場合には全原料混合体12の体積の合計)をv[cm³]としたとき、3v≦V≦5sの関係を満たしていることが好ましい。これにより、原料混合体12は耐熱容器13内に適当な空間をおいて載置されるので、温度分布の乱れによる影響を抑えることができる。また、耐熱容器13の容積に対して適当な雰囲気ガスの流量が設定されるので、耐熱容器13内の酸素濃度が短時間で平衡に達することができ、十分な応答速度をもって雰囲気を制御することができる。

[0095]

また本発明による熱処理炉においては、図11に示すように、加熱炉11内に原料混合体

10

20

30

1 2 が底に載置された耐熱容器 1 3 が配置されている。耐熱容器 1 3 は蓋 1 3 a と本体 1 3 b が嵌合するように構成されこれらの嵌合部 1 3 d の隙間は所定値(0. 1 m m)以下に設定されている。加熱炉 1 1 と耐熱容器 1 3 の間には所定濃度の酸素ガスを含む雰囲気ガスが充填されている。耐熱容器 1 3 には内部の気体を導出するガス導出管 1 5 のみが設けられている。ガス導出管 1 5 には耐熱容器 1 3 内部の酸素濃度を測定する吸引式の酸素濃度計 1 8 が直列に接続されている。この酸素濃度計 1 8 により耐熱容器 1 3 内の気体が吸引されると嵌合部 1 3 d の隙間から加熱炉内の雰囲気ガスが流入される(図 1 1 (a)の矢印にて示す)。またこの隙間からガス導出管 1 5 に向かう気流(図 1 1 (b)における破線矢印にて示す)中に原料混合体 1 2 が載置されるので、原料混合体 1 2 は常に新しい雰囲気ガスに曝されている。これによれば、酸化物超電導体を製造する工程において耐熱容器 1 3 内をほぼ一定の酸素濃度に維持することができるので、簡便で安価な装置により溶融法による酸化物超電導体を製造するのに最適な雰囲気を提供することができる。

[0096]

また、上述した耐熱容器 1 3 は蓋 1 3 a と容器本体 1 3 b の 2 つの部材から構成されていたが、3 つ以上の部材から構成されるようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は本発明による酸化物超伝導体を製造する熱処理炉の一実施の形態を示す断面図であり、(b) は同実施の形態の加熱炉内を示す上面図である。

【図2】本発明による酸化物超伝導体の製造方法の耐熱容器内の温度と酸素濃度を示す図である。

【図3】本発明による酸化物超伝導体の製造方法の実施例1により作製した酸化物超電導体の捕捉磁場の分布を示す図である。

【図4】本発明による酸化物超伝導体の製造方法の実施例2により作製した酸化物超電導体の捕捉磁場の分布を示す図である。

【図5】本発明による酸化物超伝導体の製造方法の実施例3により作製した酸化物超電導体の捕捉磁場の分布を示す図である。

【図 6 】酸化物超伝導体の製造方法の比較例により作製した酸化物超電導体の捕捉磁場の分布を示す図である。

【図7】試料中央部の超電導臨界温度と放出酸素量との関係を示す図である。

【図8】原料粉のSm123とSm211との配合比率と、この配合比率における、目的とする超電導臨界温度を得るための最適な放出酸素量との相関関係を示す図である。

【図9】本発明による酸化物超伝導体を製造する熱処理炉の他の実施の形態を示す断面図である。

【図10】 (a) は本発明による酸化物超伝導体を製造する熱処理炉の他の実施の形態を示す断面図であり、(b) は同実施の形態の加熱炉内を示す上面図である。

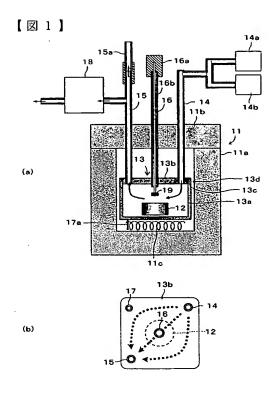
【図11】 (a) は本発明による酸化物超伝導体を製造する熱処理炉の他の実施の形態を示す断面図であり、(b) は同実施の形態の加熱炉内を示す上面図である。

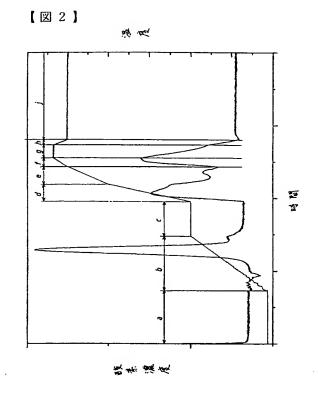
【符号の説明】

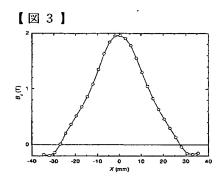
1 1 ··· 加熱炉、1 2 ··· 原料混合体、1 3 ··· 耐熱容器、1 3 a ··· 容器本体、1 3 b ··· 蓋、1 3 d ··· 嵌合部、1 4 ··· ガス導入管、1 5 ··· ガス導出管、1 6 ··· 種結晶導入管、1 8 ··· 酸素 濃度計。

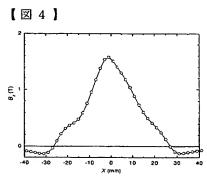
20

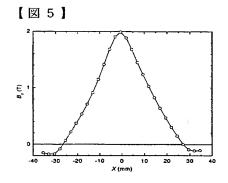
30

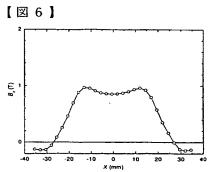


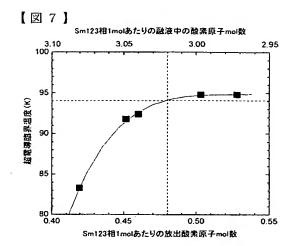


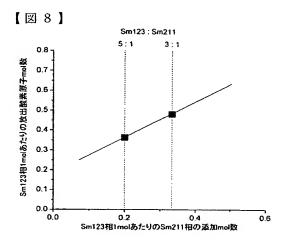


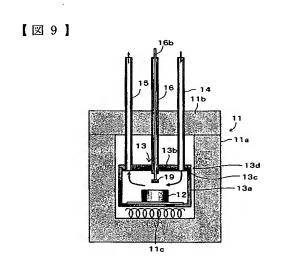


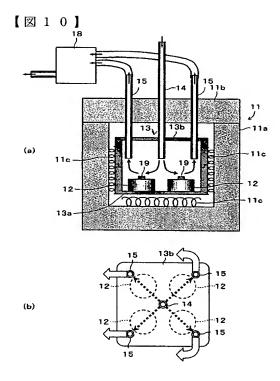


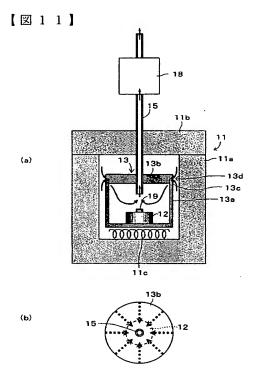












フロントページの続き

(72) 発明者 水谷 宇一郎 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学内

(72)発明者 生田 博志 愛知県名古屋市千種区不老町 名古屋大学内

F ターム(参考) 4G047 JA02 JB03 JB04 JC02 KA01 KC05 KC06 LA01 LA02 4G077 AA02 BC53 CD10 EA07 EG21 EG25 MB14 MB21 MB35

5G321 AA02 AA04 CA02 DB28 DB46 DB47 DB48